

QURĞUŞUN SELEN ƏSASINDA ALINMIŞ ƏRİNTİLƏRİN FİZİKİ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ (300 K)

**M.Ə. ƏLİCANOV, N.M. ORUCOV, A.O. MEHRABOV, S.M. ƏLİCANOVA,
N.U. İBAYEV**

*AZ-1073, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat İnstitutu, Bakı, Ayna Sultanova küçəsi 5,,
1143, Bakı, Hüseyn Cavid, 33, MEA Kimya problemləri İnstitutu*

Qurğuşun selen birləşməsində CrSe-nin həll olma sahəsi müəyyən edilmiş, bərk məhlul sahəsindəki ərintilərin: 2,4,6 mol% tərkibli nümunələrin fiziki xassələri 300K temperaturda ölçülümdür. PbSe birləşməsində olduğu kimi onun əsasındaki nümunələr də kub quruluşa malik olub, elektron tip yarımkəcəricilərdir. Həm əsas komponentin (PbSe) və onun əsasındaki ərintilərin: Termoelektrik parametrləri (Termo e.h.q., istilikkeçirmə, elektrikkeçirmə) ölçülümdür. Holl effektini ölçməklə yükdaşıyıcıların konsentrasiyası və yürüklüyü hesablanmışdır.

$\text{Al}^{\text{IV}}\text{Bi}^{\text{IV}}$ tipli birləşmələr yarımkəcərici materiallar kimi geniş öyrənilmiş və hal-hazırda öyrənilməkdədir. Bu birləşmələr əsasında alınmış ərintilər praktiki və elmi cəhətdən tədqiqatçıları daha çox maraqlandırır. Həmin tip birləşmələrdən PbSe və onun əsasındaki ərintilər termofotoelektrik material kimi yarımkəcəricilər texnikasında geniş tətbiq olunur. PbSe sistemində 1361K temperaturunda əriyən bir konkurent birləşmə halını alır. Bu birləşmə kub quruluşda kristallaşaraq, kiçik qadağan olunmuş zolağa malik yarımkəcəricilərə aid olur [1,2].

Fiziki kimyəvi analiz metodlarından istifadə etmək $(\text{PbSe})_{1-x} \text{CrSe}_x$ sistemində PbSe tərəfdən 8 mol%-ə qədər (300K) bərk məhlul sahəsi müəyyən edilmişdir. PbSe birləşməsinin və 2,4,6 mol % CrSe tərkibli nümunələrin fiziki xassələri 300K temperaturunda ölçülümdür. Cədvəl 1-də göstərilmişdir ki, kristal qəfəs sabiti tərkibdən asılı

olaraq artır və 6 mol% CrSe tərkibli nümunə üçün 6.31 Å olur. Bu artım Pb və Ni atomlarının ion radiuslarının müxtəlif olması ilə əlaqədardır. Elektrikkeçirmənin qiyməti PbSe üçün $362 \text{ om}^{-1}\text{sm}^{-1}$ olduğu halda, 6 mol % CrSe tərkibli nümunə üçün azalaraq $267 \text{ om}^{-1}\text{sm}^{-1}$ olur. Termo-e.h.q.nin qiyməti əksinə 282 mkv/dər ilə 312 mkv/dər qiymətləri arasında dəyişərək artır. İstilikkeçirmə tərkibdən asılı olaraq azalır, $12,62 \text{ Wt sm.dər}$ (PbSe üçün) isə $10,96 \text{ Wt/(sm.dər)}$ (6mol% CrSe tərkibli nümunə üçün) qiymətləri arasında dəyişir. Bu hal, bərk məhlul sahəsi üçün xarakterikdir. Yük daşıyıcıların komppensasiyası $4.7 \cdot 10^{18} \text{ sm}^{-3}$ ilə $6.6 \cdot 10^{19} \text{ sm}^{-3}$ qiymətləri arasında artdığı halda yükdaşıyıcıların yürüklüyü $958 \text{ sm}^2/(\text{v.san})$ ilə $972 \text{ sm}^2/(\text{v.san})$ arasında azalır. Bu isə tamamilə qanuna uyğun hesab edilə bilər.

($\text{PbSe})_{1-x}(\text{Cr Se})_x$ sistemli ərintilərin fiziki xassələri (300K)

Cədvəl №1

Tərkib, $(\text{PbSe})_{1-x}$ $(\text{CrSe})_x$	Qəfəs sabiti, $\sigma, \text{Å}$	Elektrik- keçirmə $\sigma, \text{om}^{-1}\text{sm}^{-1}$	Termo- ehq. $\alpha, \text{mkv/dər}$	İstilikkeçirmə $\chi, \text{Bm/dereca}$ ($\text{sm}^2/\text{dereca}$)	Yükdaşıyıcıların konsentrasiyası, n, sm^{-3}	Yükdaşıyıcı-ların yürüklüyü, $\mu, \text{sm}^2/(\text{b.sah})$	Qadağan olunmuş zolağın eni $\Delta E, \text{eV}$	Keciriciliyin tipi, n, g
0,00	6,14	362	282	12,62	$4,7 \cdot 10^{18}$	958	0,30	pp
0,02	—	326	276	12,23	$8,2 \cdot 10^{18}$	916	0,36	pp
0,04	6,21	285	297	11,46	$2,2 \cdot 10^{19}$	876	0,43	pp
0,06	6,31	267	312	10,96	$6,6 \cdot 10^{19}$	792	0,51	pp

Tədqiq olunmuş nümunələr üçün qadağan olunmuş zolağın eni hesablanmış və onun 0,30 ev ilə 0,51 ev qıymətləri arasında dəyişdiyi müəyyən olunmuşdur. ΔE -nin tərkibdən asılı olaraq belə dəyişməsi, qəfəs sabitinin

dəyişməsi ilə əlaqədardır. Termoelektrik hərəkət qüvvəsinin işarəsinin dəyişməsinə görə PbSe-nin «P» tip, onun əsasındaki ərintilərin isə «n» tip keçiriciyə malik olduğu müəyyən edilmişdir. Keçiriciliyinin tipinin

dəyişməsi qurğusunun (Pb^{+2}) və $Cr(Cr^{+3})$ atomlarının elektrik mənfilinin müxtəlifliyi ilə izah oluna bilər.

Elektrikkeçirmə və termo e.h.q.-nin tərkibdən asılı olaraq dəyişməsi yüksəlyicilərin konsentrasiyası və yürüklüğünün qiymətlərinin $CrSe$ -nin miqdarının $PbSe$ -də artması ilçə əlaqələndirilir. Keçiriciliyin tipinin dəyişməsi

qürüşün (Pb^{+2}) və $Cr (Cr^{+3})$ atomlarının elektromənfilinin müxtəlifliyi ilə izah olunur. Elektrikkeçirmə və termo-e.h.q.-nin tərkibdən asılı olaraq dəyişməsi yüksəlyicilərin konsentrasiyası və yürüklüğünün qiymətlərinin $CrSe$ -nin miqdarının $PbSe$ -də artması ilə əlaqələndirilir.

- [1] Yu.P. Paviç, V.A. Efimova, I.A. Smirnova. Metodi issledovaniya poluprovodnikov v primenie xalkogenidov svintsa $PbTe$, $PbSe$, PbS . Moskva, izdatelstvo Nauka, 1968, 394 s.

- [2] M.A. Alidjanov. Zakonomernost svoystv v soedineniyax $A^{IV}B^{IV}$. Moskva, izdatelstvo VNITI, 1987, 96s.

М.А. Алиджанов, Н.М. Оруджев, А.О. Мехрабов, С.М. Алиджанова, Н.И. Ибаев

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИМЕСЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ PbSe

Определена область твердого раствора на основе соединения селенида свинца, которая составляет до 6 мол % $PbSe$. Измерены физические свойства соединений $PbSe$ и сплавов содержащих 2,4 и 6 мол % $CrSe$ при 300 К.

Сплавы на основе $PbSe$ имеют кубическую структуру и являются полупроводниками электронного типа.

Измерены термоэлектрические параметры (термо э.д.с., теплопроводность, электропроводность), как основного компонента ($PbSe$) так и сплавов на его основе. Вычислены концентрация и подвижность носителей заряда на основе измерения эффекта Холла.

М.А. Алиджанов, Н.М. Оруджев, А.О. Мехрабов, С.М. Алиджанова, Н.И. Ибаев

INVESTIGATION OF IMPURITY PHYSICAL PROPERTIES OBTAINED ON THE BASE OF PbSe

The region of the solid solution based on plumbum selenide compound, which compounds up to 6 moth % of $CrSe$. Physical properties of $PbSe$ compound and alloys containing 2.4 and 6 moth % $CrSe$ at 300 K are measured.

Alloys based on $PbSe$ have cubic structure and are electronic type semiconductors.

Thermo-electric parameters (thermo edc, thermal conductivity, electric conduction) of the main component ($PbSe$) and alloys based on it are measured. Concentration and mobility of current carriers based on Hall effect measurement are calculated.

Received: 07.01.05